



**Toshiba introduce i MOSFET di potenza a canale N da 100V per applicazioni automotive**

Il nuovo dispositivo è il primo della nuova serie U-MOS X-H di Toshiba ad essere prodotto

**Düsseldorf, Germania, 03 Marzo 2020** – Toshiba Electronics Europe GmbH ha introdotto un nuovo MOSFET di potenza a canale N da 100V adatto per applicazioni negli apparecchi automotive come interruttori di carico, alimentatori a commutazione e azionamenti di motori.

Il nuovo XK1R9F10QB è il primo dispositivo disponibile della nuova serie di MOSFET U-MOS-H di Toshiba dotati di una struttura di trench, ed è fabbricato nel processo di ultima generazione dell'azienda. Incapsulato all'interno di un package TO-220SM (W) a bassa resistenza, il componente offre livelli di resistenza di ON ( $R_{DS(on)}$ ) all'avanguardia del settore con un valore massimo di 1,92 mΩ con una  $V_{GS}$  di 10V. Questo rappresenta un miglioramento/riduzione di circa il 20% rispetto ai dispositivi attuali come il

TK160F10N1L, e contribuisce così a ridurre il consumo di potenza e ad aumentare l'efficienza nelle applicazioni automotive. L'XK1R9F10QB presenta anche un rumore di commutazione ridotto, grazie all'ottimizzazione delle sue caratteristiche di capacità, che contribuisce a ridurre le EMI.

Il nuovo dispositivo è in grado di sopportare una tensione drain-source ( $V_{DSS}$ ) di 100V ed è progettato per una corrente continua di drain ( $I_D$ ) di 160A, o di 480A se impulsata ( $I_{DP}$ ). Il dispositivo può funzionare con una temperatura di canale di 175°C e presenta un'impedenza termica fra il canale e il case ( $Z_{th(ch-c)}$ ) inferiore a 0,4°C/W, con un miglioramento delle prestazioni termiche.

Il MOSFET XK1R9F10QB è qualificato in base allo standard AEC-Q101 per applicazioni automotive ed è liberamente disponibile un modello PSpice di ausilio nella simulazione rapida.

Le consegne in volumi di produzione del nuovo dispositivo hanno inizio da oggi.

Per ulteriori informazioni sui nuovi MOSFET di Toshiba seguite il link qui sotto:  
<https://toshiba.semicon-storage.com/eu/semiconductor/product/mosfets/12v-300v-mosfets/detail.XK1R9F10QB.html>

###

**Informazioni su Toshiba Electronics Europe**

[Toshiba Electronics Europe GmbH](#) (TEE) è la divisione Europea dedicata alla produzione di componenti elettronici di [Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation](#) (Toshiba). TEE offre ai consumatori e alle aziende Europee un'ampia varietà di unità a disco rigido (HDD), oltre a soluzioni su semiconduttore per applicazioni automotive, industriali, IoT, per il controllo del movimento, telecom, di rete, consumer e per gli elettrodomestici. Il vasto portafoglio di prodotti della società comprende IC wireless integrati, semiconduttori di potenza, microcontrollori, semiconduttori ottici, ASSP e dispositivi discreti che vanno dai diodi agli IC logici.

TEE ha sede principale a Düsseldorf in Germania, con filiali in Francia, Italia, Spagna, Svezia e nel Regno Unito con attività di progettazione, produzione, marketing e vendite. Il presidente della compagnia è il sig. Tomoaki Kumagai.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web di Toshiba Electronics Europe all'indirizzo [www.toshiba.semicon-storage.com](http://www.toshiba.semicon-storage.com).

**Indirizzo di riferimento da pubblicare:**

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germany

Tel: +49 (0) 211 5296 0 Fax: +49 (0) 211 5296 79197

Web: [www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html](http://www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html)

E-mail: [discrete-ic@toshiba-components.com](mailto:discrete-ic@toshiba-components.com)

**Contatto per i giornalisti:**

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH

Tel: +44 (0) 1932 822 832

E-mail: [MShrimpton@teu.toshiba.de](mailto:MShrimpton@teu.toshiba.de)

**Comunicato emesso da:**

Birgit Schöniger, Publitek

Tel: +44 (0) 1582 390980

Web: [www.publitek.com](http://www.publitek.com)

E-mail: [birgit.schoeniger@publitek.com](mailto:birgit.schoeniger@publitek.com)

Marzo 2020

Rif. 7265